

실험 9 증가형 MOSFET의 전류-전압 특성

- 이름 :
- 실험일 :

시뮬레이션 9-1 | N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{DS}$ 특성 해석하기

표 9-2 N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{DS}$ 특성 시뮬레이션 결과

I_D [mA]		V_{DS} [V]					
		0.1	0.4	0.8	2.0	4.0	5.0
V_{GG} [V]	1						
	2						
	3						
	4						
	5						



그림 9-10 N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{DS}$ 특성 시뮬레이션 결과 파형

시뮬레이션 9-2 | N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{GS}$ 특성 해석하기

표 9-3 N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{GS}$ 특성 시뮬레이션 결과($V_{DS} = 4V$)

I_D [mA]	V_{GG} [V]								
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

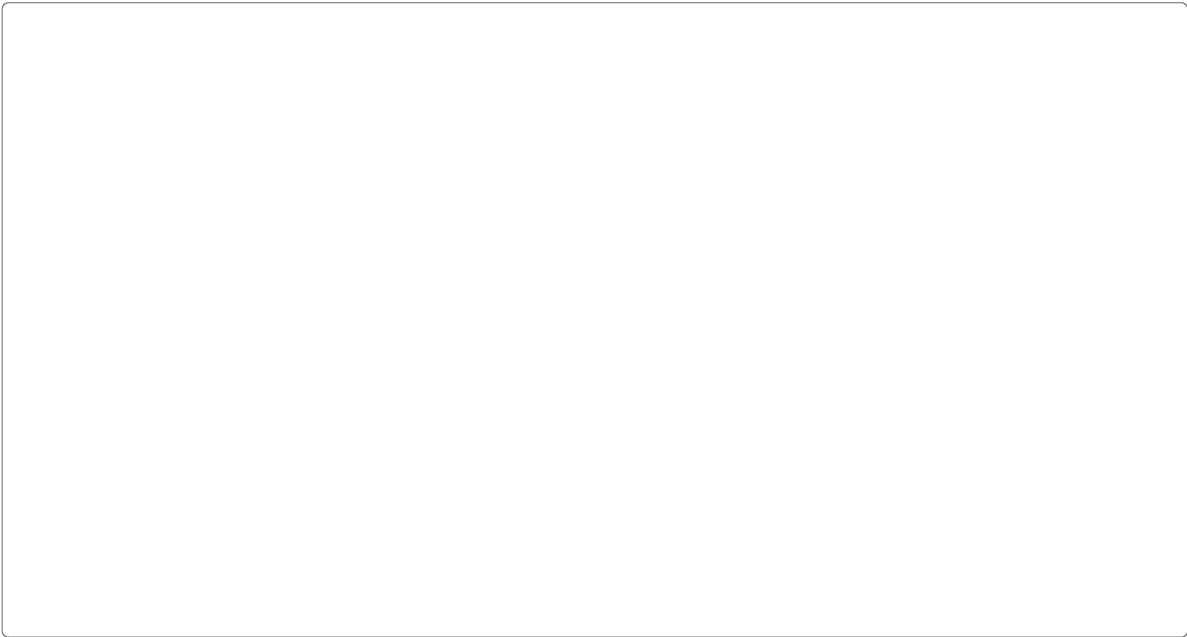


그림 9-11 N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{GS}$ 특성 시뮬레이션 결과 파형

시뮬레이션 회로

■ 시뮬레이션 9-1 회로



■ 시뮬레이션 9-2 회로

